課題番号	:	F-16-WS-0002
利用形態	:	技術代行
利用課題名(日本語)	:	強誘電体セラミックス薄膜の微細加工および微構造評価
Program Title (English)	:	$\operatorname{Micro-machining}$ and microstructure characterization of ferroelectric thin films
利用者名(日本語)	:	坂本 渉
Username (English)	:	<u>Wataru Sakamoto</u>
所属名(日本語)	:	名古屋大学 未来材料・システム研究所
Affiliation (English)	:	Institute of Materials and Systems for Sustainability, Nagoya University

<u>1. 概要(Summary)</u>

BiFeO₃(BF)は室温を含む広い温度域で強誘電性と (反)強磁性を同時に発現する物質であり、これら異なるフ エロイックな物性間の相互作用を利用した新規デバイスへ の応用が期待されている。一方、BF系化合物は多くの酸 化物強誘電体の中でも比較的狭いバンドギャップ 1-3)を有 しているため、可視光照射下での光誘起特性4.5)にも注目 が集まっている。しかし、BF をはじめとした強誘電体材料 は一般に得られる光電流が微弱であり、これを増加させる ことが大きな課題となる。また、近年のデバイスの小型化 や高集積化の進展は目覚ましく、BF など機能性材料の 薄膜化は必須となっている。本研究グループでは、これま でにBF薄膜中にAgナノ粒子を複合化することでBFの 強誘電性を維持しつつ、Ag の局在表面プラズモン共鳴 の効果により光電流を増加させることに成功している。ここ では、この複合膜に対して FIB (focused ion beam)加工 および HR-SEM (high resolution-scanning electron microscope)微構造観察、EDX (Energy Dispersive X-ray spectroscopy)組成分析を行った。

<u>2. 実験(Experimental)</u>

【利用した主な装置】

収束イオン/電子ビーム加工観察装置(極表面微量元素 分析機能つき)

【実験方法】

BF 系薄膜は、組成制御および薄膜試料の作製が容 易な化学溶液法により作製した。出発原料には各構成元 素の金属アルコキシド、溶媒には 2-メトキシエタノールを 選択して BF 前駆体溶液を調製した。BF 単独膜の場合 はこの溶液を基板上に所望の回数スピンコートし、乾燥、 加熱処理による結晶化を行うことで薄膜を作製した。一方、 BF と Ag ナノ粒子の複合膜に関しては、BF 膜を数回コ ート・加熱処理した後、スパッタ法により Ag ナノ粒子を堆 積することで BF 薄膜中に Ag ナノ粒子層を複合化させた。 ここでは、Ag ナノ粒子層を含まない BF 単独膜と BF 膜を 二等分する位置にナノ粒子層を複合化した膜(BAB)膜お よび BF 膜を三等分する位置にナノ粒子層を複合化した 膜(BABAB)膜の三種類の薄膜を作製した(Fig. 1)。薄 膜の結晶化処理は O2 雰囲気下 600 °C で行った。また、 基板には SrTiO₃(100)および Pt/TiO₄/SiO₂/Si 基板を用 いた。作製した薄膜については微構造観察および光学的 および電気的特性の評価を行った。



Fig. 1 Schematic illustrations of prepared (a) BiFeO₃ (BF), (b)BiFeO₃/Ag nanoparticle/BiFeO₃ (BAB), and BiFeO₃/Ag nanoparticle/BiFeO₃/Ag nanoparticle/BiFeO₃ (BABAB) thin films on Pt/TiO₂/SiO₂/Si substrates.

<u>3. 結果と考察(Results and Discussion)</u>

作製した薄膜のXRD測定結果より、全ての薄膜におい てペロブスカイトBF単相となり、不純物相は確認されなか った。AFM 観察より、作製した薄膜は結晶粒の粒径が 50-100 nm であり良好な表面微構造を有していた。 SrTiO₃(100)基板上に作製したBF単独膜およびBF-Ag ナノ粒子複合膜に対して紫外・可視光透過スペクトルを測 定した結果からバンドギャップを見積もったところ、約 2.2 eVとなった。また、BF および BAB, BABAB 薄膜の光電 流挙動を調べるために、キセノンランプを用いた可視光照 射 on-off 状態での薄膜上部・下部電極間を短絡したとき に流れるゼロバイアス電界下での電流値を測定した。その 結果、BF 膜自体の電気的特性や強誘電特性をほぼ変 化させることなく、Ag ナノ粒子を複合化させることで光電 流値が約 2~4 倍に増大した。これは、Ag ナノ粒子の局 在表面プラズモン共鳴の効果により、BF 単独膜の場合よ りも光励起された電子の生成が促進され、電荷キャリアの 量が増加したためであると考えられる。さらに、この複合膜 について FIB 加工および断面の HR-SEM 微構造観察 を行ったところ、薄膜の断面像からは空隙等がやや見ら れるものの、均一な膜厚を有する複合膜となっていること がわかった(Fig. 2(a))。さらに、EDS による元素分析を 行ったところ、複合膜の断面の Ag ナノ粒子を複合化した 部位(Fig. 2(a)の白点線枠内, Fig. 1(c)構造試料)から AgL 線のシグナル(Fig. 2(b)矢印部)が確認できた。



Fig. 2 (a) SEM image and (b) EDX spectrum (in dotted circle area surrounded by white line in Fig. 2(a)) of Ag nanoparticles-BiFeO₃ composite film

4. <u>その他・特記事項(Others)</u>

·参考文献

- F. Gao, Y. Yuan, K. F. Wang, X. Y. Chen, F. Chen, J.-M. Liu, and Z. F. Ren, *Appl. Phys. Lett.*, 89, 102506 (2006).
- F. Gao, X. Chen, K. Yin, S. Dong, Z. Ren, F. Yuan, T. Yu, Z. Zou, and J.-M. Liu, *Adv. Mater.*, 19, 2889-2892 (2007).
- A. Kumar, R. C. Rai, N. J. Podraza, S. Denev, M. Ramirez, Y.-H. Chu, L. W. Martin, J. Ihlefeld, T.

Heeg, J. Schubert, D. G. Schlom, J. Orenstein, R.Ramesh, R. W. Collins, J. L. Musfeldt, and V.Gopalan, *Appl. Phys. Lett.*, **92**, 121925 (2008).

- T. Choi, S. Lee, Y. J. Choi, V. Kiryukhin, and S.-W. Cheong, *Science*, **324**, 63-66 (2009).
- S. Y. Yang, J. Seidal, S. J. Byrnes, P. Sharfer, C.-H. Yang, M. D. Rossell, P. Yu, Y.-H. Chu, J. F. Scott, J. W. Ager, L. W. Martin, and R. Ramesh, *Nat. Nanotechnol.*, 5, 143-147 (2010).

•謝辞

本研究の一部は「文部科学省学際国際的高度人材育 成ライフイノベーションマテリアル創製共同研究プロジェク ト」(2016年度~2020年度)のもとで行われました。

電子顕微鏡観察用試料作製および微構造観察にご協 カいただきました由比藤勇准教授および竹内輝明教授 (早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構)に感謝します。

5. 論文·学会発表(Publication/Presentation)

- R. Maruyama, W. Sakamoto, I. Yuitoo, T. Takeuchi, K. Hayashi, and T. Yogo, *Jpn. J. Appl. Phys.*, 55, 10TA14 (2016).
- (2) R. Maruyama, K. Hayashi, W. Sakamoto, I. Yuitoo, T. Takeuchi, T. Yogo, *The 1st International Symposium on Creation of Life Innovation Materials for Interdisciplinary and International Researcher Development (iLIM-1)*, October 17 (2015), Osaka (Japan).
- (3) 丸山 莉果,林 幸壱朗,坂本 渉,由比藤 勇,竹内 輝明,余語 利信,第 55 回セラミックス基礎科学討論 会,2017年1月13日,岡山市.

6. 関連特許(Patent)

なし。